

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 111年度行專訴字第52號

03 民國112年5月4日辯論終結

04 原 告 友威科技股份有限公司

05 代 表 人 李原吉

06 訴訟代理人 楊理安律師

07 趙嘉文專利師

08 吳俊億專利師

09 被 告 經濟部智慧財產局

10 代 表 人 廖承威

11 訴訟代理人 韓薰蘭

12 簡昭萸

13 參 加 人 凌嘉科技股份有限公司

14 代 表 人 陳連春

15 訴訟代理人 陳冠宏律師

16 蔣昕佑律師

17 陳豫宛專利師

18 上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
19 1年7月13日經訴字第11106304890號訴願決定，提起行政訴訟，
20 並經本院命參加入獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

21 主 文

22 一、訴願決定及原處分關於更正後請求項1至10部分均撤銷。

23 二、被告就新型第M499418號「連續型同步鍍膜設備」專利舉發
24 事件(104200991N01)，應作成更正後「請求項1至10舉發成
25 立，應予撤銷」之審定。

26 三、訴訟費用由被告負擔。

27 事實及理由

28 一、程序方面：

29 (一)被告代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休後，已由廖承
30 威於同年月20日接任局長並於同年月27日聲明承受訴訟，

01 此有經濟部函文及聲明承受訴訟狀在卷可稽（卷一第469
02 至476頁），核無不合，應予准許。

03 （二）原告於行政訴訟所提附表之甲證3，及其與原舉發證據即
04 「證據2、6、7」及「證據2、6、7、8」之組合，雖均未
05 於本件舉發及訴願階段提出，惟其係就同一撤銷理由所提
06 出之新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，
07 本院就該證據及其證據組合仍得併予審究。

08 （三）參加人在本件行政訴訟階段於112年1月18日向被告申請更
09 正本件專利請求項1（卷一第379至385頁），並於同年3月
10 1日經被告准予更正並公告在案（卷二第23頁），且兩造
11 及參加人均同意本件審理標的以更正公告後之請求項為準
12 （卷二第30頁），故原告就附帶聲明更正為「訴願決定及
13 原處分關於更正後請求項1至10部分均撤銷」，課予被告
14 義務之主要聲明在請求項1至10前新增「更正後」文字，
15 係為使其聲明更加明確，非屬訴之變更，先予敘明。

16 二、爭訟概要：參加人前於104年1月21日以「連續型同步鍍膜設
17 備」向被告申請新型專利，申請專利範圍共10項，經編為第
18 104200991號進行形式審查後，於同年2月24日准予專利，並
19 發給新型第M499418號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告
20 以系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第1項第1
21 款及第2項規定，提起舉發。案經被告審查，以111年3月3日
22 （111）智專三(五)01058字第11120212690號專利舉發審定書
23 為「請求項1至10舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原
24 告不服提起訴願，經經濟部於111年7月13日以經訴字第1110
25 6304890號訴願決定書予以駁回（下稱訴願決定），原告仍
26 不服而提起本件訴訟。又本院認為本件判決之結果將影響參
27 加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本
28 件訴訟。

29 三、原告主張及聲明：

30 （一）證據6足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

01 1.證據6已揭露系爭專利請求項1之「一個連續型同步鍍膜設
02 備」、「一個真空腔體1，包括(n+1)個緩衝區間11，及n
03 個鍍膜區間12，該等緩衝區間11與該等鍍膜區間12是沿一
04 排列方向X依序輪流設置， $n \geq 2$ 且是正整數」、「n個陰極
05 濺鍍靶組合2，分別對應設置在該n個鍍膜區間12，每一陰
06 極濺鍍靶組合2具有至少一種靶材21」、「多個載具」等
07 技術特徵。所屬技術領域中具有通常知識者可藉由證據6
08 之揭露及教示，輕易完成請求項1「其中，每一載具3於各
09 鍍膜區間12中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間12與各
10 鍍膜區間12前後的緩衝區間11三者間來回地移動」技術特
11 徵。又觀諸參加人於103年12月25日申請第103145499號
12 「多層膜的量產方法」發明專利說明書之先前技術(甲證
13 6)，可知待鍍物於鍍膜區間來回移動兩次或以上，為所屬
14 技術領域中之人的通常知識。

15 2.證據6具有傳輸系統，且說明書第[0035]段已揭露：「輸
16 送系統7位於具有等離子體清潔功能之載入腔體8、第一低
17 壓腔體3、製程腔體4、第二低壓腔體5以及載出腔體6之內
18 部。製程腔體4具有彼此連通且依序設置之第一緩衝空間4
19 1、第一沉積空間42、第三緩衝空間45、第二沉積空間43
20 以及第二緩衝空間44」，因此所屬技術領域中具有通常知
21 識者可輕易完成系爭專利請求項1之「一傳輸機構4，設置
22 於該真空腔體1，且於該等緩衝區間11、該等鍍膜區間12
23 連續地設置，用以傳輸該等載具3進行各鍍膜程序」技術
24 特徵。

25 3.原處分及訴願決定無視證據6第5圖明顯地揭露多個待鍍物
26 A，置放於第一沉積空間42及第二沉積空間之教示，僅以
27 證據6之說明書文字並未記載為由，逕認證據6未揭露有多
28 個待鍍物，並不可採。

29 (二) 甲證3足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

30 1.甲證3已揭露請求項1之「一個連續型同步鍍膜設備」、
31 「多個載具」、「(n+1)個緩衝區間」、「n個鍍膜區

01 間」、「該等緩衝區間11與該等鍍膜區間12是沿一排列方
02 向X依序輪流設置， $n \geq 2$ 且是正整數」等技術特徵。又依
03 甲證3說明書第[0051]段內容已揭露「n個陰極濺鍍靶組合
04 2，分別對應設置在該n個鍍膜區間12，每一陰極濺鍍靶組
05 合2具有至少一種靶材21」技術特徵。

06 2. 依甲證3說明書第[0057]段揭露內容，所屬技術領域中具
07 有通常知識者可藉由甲證3之FIG. 1A至1C上的多個基板10
08 以及箭頭指向，並參考說明書第[0046]段對於傳遞單元進
09 行待鍍物A的輸送方式，即足以直接且無歧異得知其實質
10 相同於請求項1中「其中，每一載具3於各鍍膜區間12中執
11 行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間12與各鍍膜區間12前後
12 的緩衝區間11三者間來回地移動」技術特徵。

13 3. 又所屬技術領域中具有通常知識者亦可藉由甲證3之FIG. 1
14 B及1C，並至少參考說明書中第[0056]及[0057]段對於傳
15 遞單元由左至右進行基板10的輸送方式，即輕易思及並完
16 成請求項1之「一傳輸機構4，設置於該真空腔體1，且於
17 該等緩衝區間11、該等鍍膜區間12連續地設置，用以傳輸
18 該等載具3進行各鍍膜程序」技術特徵。

19 (三) 證據2、6、7及甲證3之組合，足以證明系爭專利請求項1
20 不具進步性：

21 1. 如前所述，證據6已揭露系爭專利請求項1之全部技術特
22 徵，縱未如此，證據7揭露一種基板真空濺射設備，及兩
23 個基板依序設置於製成產線中，進行濺鍍塗覆作業，且可
24 於濺射腔室6、前後的腔室5、9(非濺射腔室)三者間往返
25 之技術內容。所屬技術領域中具有通常知識者可以結合證
26 據7教示的多個基板同步前後往返移動之技術內容，與前
27 述證據6揭露之技術特徵，即足以對應並輕易完成系爭專
28 利請求項1之所有技術特徵。故證據6、7之結合足以證明
29 系爭專利請求項1不具進步性。又原告並非單獨使用證據7
30 來證明系爭專利請求項1不具進步性，原處分對於證據7之
31 解讀有誤在先，又誤以新穎性比對方式率爾認定證據7無

01 法結合其他證據證明系爭專利請求項1不具進步性，自有
02 違誤。

03 2.證據2揭露系爭專利請求項1除了「同一真空腔體」以外之
04 全部技術特徵，亦得結合證據6及7，用以證明系爭專利請
05 求項1不具進步性。而原處分及訴願決定僅以證據2具有閘
06 門，逕認證據2無法證明系爭專利請求項1不具進步性，卻
07 完全未論就該等閘門是否具有實質影響，顯忽視系爭專利
08 請求項1實質上為證據2之簡單變更。

09 4.又甲證3已揭露有多個基板間隔排列而可依序同步移動進
10 行濺鍍工作，證據6及甲證3已明確揭露系爭專利請求項1
11 的全部結構特徵，證據2亦已揭露除「同一真空腔體」以
12 外之全部結構特徵，且證據6、2及甲證3亦均分別揭露多
13 個載具依序排列位於鍍膜生產線中之不同鍍膜區間而可進
14 行鍍膜程序的技術內容，進一步結合證據7多載具可同步
15 來回移動完成多層鍍膜之教示，所屬技術領域中具有通常
16 知識者當可輕易完成系爭專利請求項1，系爭專利請求項1
17 並不具進步性。

18 (四) 證據2、6、7、8及甲證3之組合，足以證明系爭專利請求
19 項2至10不具進步性：

20 1.證據8已揭露系爭專利請求項2、3、4至8之技術特徵，所
21 屬技術領域中具有通常知識者藉由證據8之教示，均可輕
22 易完成上開請求項之技術特徵。退言之，所屬技術領域中
23 具有通常知識者，結合證據2、或證據6、或證據7、或甲
24 證3之說明後，亦可輕易完成之。

25 2.又關於系爭專利請求項9、10，所屬技術領域中具有通常
26 知識者結合證據2、或證據6、或證據7、或甲證3之說明
27 後，亦可輕易完成之，足證系爭專利請求項2至10不具進
28 步性。

29 (五) 聲明：

30 1.訴願決定及原處分關於更正後請求項1至10部分均撤銷。

01 2.被告就新型第M499418號「連續型同步鍍膜設備」專利舉
02 發事件(104200991N01)，應作成更正後「請求項1至10舉
03 發成立，應予撤銷」之審定。

04 四、被告抗辯及聲明：

05 (一) 證據6不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

06 1.依證據6第5圖記載於說明書第[0034]至[0039]段，完全未
07 揭示「多數個載具」或「多數個待鍍物」，且從說明書第
08 [0008]段記載，再配合證據6圖4，可知待鍍物A依序通過
09 上述第一緩衝空間41、第一沉積空間42、第三緩衝空間4
10 5、第二沉積空間43以及第二緩衝空間44，並未揭示請求
11 項1之「每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能
12 於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地
13 移動」技術特徵。

14 2.又因證據6亦未揭示或暗示「各鍍膜區間與各鍍膜區間前
15 後的緩衝區間三者間來回地移動」技術特徵，且所屬技術
16 領域中具有通常知識者無法輕易由證據6推及或完成請求
17 項1，故不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

18 (二) 甲證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

19 1.甲證3說明書第[0045]至[0048]、[0050]段及圖1A至1C之
20 內容揭示一種直列式連續沉積裝置之結構特徵，與系爭專
21 利請求項1「一種連續型同步鍍膜設備，包含：一個真空
22 腔體，包括(n+1)個緩衝區間，及n個鍍膜區間」結構特徵
23 不同。又甲證3亦未揭示系爭專利請求項1之「每一載具於
24 各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍
25 膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」技術特徵。

26 2.由於甲證3未揭示或暗示「(n+1)個緩衝區間，及n個鍍膜
27 區間」及「各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者
28 間來回地移動」技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識
29 者亦無法輕易由甲證3推及「(n+1)個緩衝區間，及n個鍍
30 膜區間」及「各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三
31 者間來回地移動」技術特徵，無法輕易完成請求項1，故

01 甲證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

02 (三) 證據2、6、7、甲證3之組合，不足證明系爭專利請求項1
03 不具進步性：

- 04 1. 證據6未揭示系爭專利請求項1之「每一載具於各鍍膜區間
05 中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後
06 的緩衝區間三者間來回地移動」技術特徵；甲證3未揭示
07 請求項1之「一種連續型同步鍍膜設備，包含：一個真空
08 腔體，包括(n+1)個緩衝區間，及n個鍍膜區間」及「每一
09 載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間
10 與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」技術特
11 徵。
- 12 2. 又依證據7說明書第3欄第16至35行所揭示內容，與系爭專
13 利請求項1之「多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別
14 能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其
15 中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各
16 鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移
17 動」技術特徵不同。另從第2欄第39至55行揭示內容，可
18 知腔體與閘門依序為：閘門3、載入腔2、閘門3'、緩衝腔
19 4、閘門3"、輸送腔5、鍍膜腔6、輸送腔9、閘門3"、緩衝
20 腔10、閘門3'、載出腔11、閘門3。可知證據7之腔體設置
21 與系爭專利請求項1至少包含以下四個差異點：(1)證據7僅
22 包含1個鍍膜腔，不符合 $n \geq 2$ 個鍍膜區間之技術特徵；(2)
23 證據7之緩衝腔與鍍膜腔分別為單獨的真空腔體，由閘門
24 所區隔，不符合同一真空腔體包含緩衝區間與鍍膜區間之
25 技術特徵；(3)證據7之緩衝腔與鍍膜腔之間設有輸送腔，
26 不符合緩衝區間與鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置
27 之技術特徵，即未揭示請求項1之「一傳輸機構，設置於
28 該真空腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設
29 置」；(4)如前所述，證據7未揭示系爭專利之「多數個載
30 具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜
31 區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區

01 間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前
02 後的緩衝區間三者間來回地移動」。

03 3. 依證據2說明書第8欄第55行至第9欄第4行所揭示的鍍膜設
04 備，係包含一系列多個真空腔體，由多個閘門G所區隔。
05 各真空腔體依序分別為緩衝/隔離腔體3、處理腔體1、緩
06 衝/隔離腔體3'、處理腔體1'、緩衝/隔離腔體3"。證據2
07 所揭示處理腔體1、1'與緩衝/隔離腔體3、3'、3"由閘門G
08 所區隔，非位於同一真空腔體中。證據2之鍍膜裝置在進
09 行鍍膜時，閘門G為關閉的狀態，當完成一道鍍膜時，閘
10 門G才開啟使載具5離開處理腔。因此，證據2並無揭示系
11 爭專利請求項1「一個真空腔體，包括(n+1)個緩衝區間，
12 及n個鍍膜區間」之技術特徵。又證據2第9欄第5至13行內
13 容僅揭示多數個載具，對應證據2圖1與圖2之編號5、5'，
14 且證據2所揭示的鍍膜設備包含一系列多個真空腔體，由
15 多個閘門G所區隔，故證據2並未揭示系爭專利請求項1
16 「一傳輸機構，設置於該真空腔體，且於該等緩衝區間、
17 該等鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜
18 程序」之技術特徵，且證據2並未揭示系爭專利請求項1之
19 「每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍
20 膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移
21 動」。

22 4. 因證據7非屬「緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向
23 依序輪流設置」、「一傳輸機構，設置於該真空腔體，且
24 於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置」，故所屬技
25 術領域中具有通常知識者無法與證據6「緩衝區間與該等
26 鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置」之技術特徵結
27 合，亦即所屬技術領域中具有通常知識者不具組合證據6
28 與7之動機，當亦不具再與證據2、甲證3組合之動機。

29 5. 況即便組合證據2、6、7、甲證3，亦未揭示「…各鍍膜區
30 間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技
31 術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者亦無法輕易完成

01 系爭專利請求項1記載之所有技術特徵，故證據2、6、7、
02 甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

03 (四) 證據2、6、7、8及甲證3之組合，不足以證明系爭專利請
04 求項2至10不具進步性：

05 系爭專利請求項2至10為請求項1之直接或間接附屬項，包
06 含所依附之請求項全部技術特徵，而證據8並未記載或教
07 示任何關於證據2、6、7及甲證3所未揭示之「…各鍍膜區
08 間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」技術
09 特徵，亦無組合動機，且本案所屬技術領域中具有通常知
10 識者即使將證據2、6、7、甲證3之組合再以證據8組合，
11 亦無法輕易完成系爭專利所揭示之技術特徵，故組合證據
12 2、6、7、8及甲證3同樣無法證明系爭專利請求項2至10不
13 具進步性。

14 (五) 聲明：

15 1.原告之訴駁回。

16 2.訴訟費用由原告負擔；若因新證據而撤銷原處分，訴訟費
17 用由原告負擔二分之一。

18 五、參加人答辯及聲明：

19 (一) 證據6不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

20 1.依證據6說明書段落[0013]揭示內容，不具有「多數個載
21 具」承載待鍍物A，而係直接將待鍍物A傳輸進入製程腔體
22 4內，故證據6與系爭專利請求項1界定之連續型同步鍍膜
23 設備中具有「多數個『載具』，分別載放一個待鍍物且分
24 別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動」
25 之技術特徵不同。證據6亦未揭示待鍍物A在沉積空間及緩
26 衝空間來回地移動，亦未揭示系爭專利請求項1「連續型
27 同步鍍膜設備」、「其中，每一載具於各鍍膜區間中執行
28 一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝
29 區間三者間來回地移動」技術特徵。

30 2.證據6係適用於被動元件之「雙面覆膜」設備，為使待鍍
31 物在製程腔體內可雙面覆膜，故本技術領域中具有通常知

01 識者不會有動機在證據6的雙面覆膜設備中，設置載具載
02 放待鍍物，否則待鍍物被載具乘載的該面無法進行鍍膜程
03 序，而不可能完成證據6所欲的雙面覆膜之功效。且證據6
04 雖於圖4揭示2個沉積空間及3個緩衝空間，然搭配證據6說
05 明書段落[0008]揭示內容所教示技藝人士之技術內容係待
06 鍍物要依序通過各腔體，技藝人士不可能從中獲得系爭專
07 利請求項1界定之「其中，每一載具於各鍍膜區間中執行
08 一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝
09 區間三者間來回地移動」技術特徵。

10 3.原告所舉證據6未能完全揭示系爭專利請求項1之所有技術
11 特徵，且所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據6亦不
12 可能有動機於證據6的雙面覆膜設備中增設載具，亦不會
13 有動機將證據6的輸送系統修改為可於緩衝空間及沉積空
14 間中來回地移動，因此所屬技術領域中具有通常知識者無
15 法徒以證據6即輕易完成系爭專利請求項1。

16 (二) 甲證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

17 1.甲證3說明書[0045]至[0048]及圖1A揭示內容中，明顯可
18 見具有6個緩衝腔及6個沉積腔，與系爭專利請求項1中所
19 界定之「具有(n+1)個緩衝區間及n個鍍膜區間」技術特徵
20 不相同。即便將甲證3最前端的預處理腔212b與最末端的
21 後處理部219a此兩腔室一併納入觀之，惟參照甲證3圖1
22 A、說明書[0046]內容，可見預處理腔212b是作為製程用
23 途，而無法作為沉積腔213的緩衝空間，且參照說明書[00
24 47]、[0048]段內容，亦可知緩衝腔212a至218a的功效僅
25 在於避免受到相鄰蒸鍍腔的沉積材料的污染，因此後處理
26 部219a亦無法作為緩衝空間，更非沉積腔體。

27 2.甲證3均未揭示其沉積裝置中包含「載具」及「每一載具
28 於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各
29 鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，從甲證3
30 段落[0054]揭示內容可知，並不具有「多數個載具」承載
31 待鍍物(即甲證3的基板)，其係直接將待鍍物傳輸進入沉

01 積腔體內。又甲證3僅於說明書段落[0057]最後一句揭示
02 「傳遞單元將基板10在其中以圖面自左至右之方向傳
03 遞」，未揭示請求項1技術特徵1C之「每一載具於各鍍膜
04 區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間
05 前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵。

06 3.此外，甲證3與系爭專利所欲解決的問題及技術手段大有
07 不同，所屬技術領域中的通常知識當欲解決系爭專利之問
08 題時，不會有動機參考甲證3或改良甲證3之結構。再者，
09 甲證3並無任何教示或建議，會使所屬技術領域中具有通
10 常知識者，將之改良而輕易完成系爭專利請求項1之技術
11 特徵1A「具有(n+1)個緩衝區間及n個鍍膜區間」及請求
12 項1之技術特徵1C界定「多數個『載具』，分別載放一個
13 待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝
14 區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程
15 序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者
16 間來回地移動」技術特徵。故系爭專利請求項1相對於甲
17 證3具有進步性無疑。

18 (三)證據2、6、7、甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1
19 不具進步性：

20 1.證據6、甲證3均無揭示系爭專利請求項1之技術特徵，已
21 如前述。

22 2.證據2未揭示系爭專利請求項1中「一個真空腔體，具有(n
23 +1)個緩衝區間及n個鍍膜區間」、「多數個載具，分別載
24 放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多
25 數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一
26 鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區
27 間三者間來回地移動」及「一傳輸機構，設置於該真空腔
28 體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以
29 傳輸該等載具進行各鍍膜程序」技術特徵。

30 3.證據7僅揭示1個濺鍍腔因而僅有1個鍍膜區間，並非輪流
31 設置緩衝腔與濺鍍腔，且證據7之緩衝腔與輸送腔間由閥

01 門所區隔，因此緩衝腔與鍍膜腔為個別獨立之真空腔體，
02 並未揭示系爭專利請求項1之「一個真空腔體，包括(n+1)
03 個緩衝區間，及n個鍍膜區間，該等緩衝區間與該等鍍膜
04 區間是沿一排列方向依序輪流設置」、「具有多數個載
05 具，且該載具係分別載放待鍍物且分別能被控制地於該多
06 數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各
07 鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜
08 區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」技術特徵。

09 4. 況證據2、6、7及甲證3的裝置配置大相逕庭，彼此間無結
10 合動機，更遑論前揭證據均未揭示系爭專利請求項1之
11 「具有多數個載具，且該載具係分別載放待鍍物且分別能
12 被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其
13 中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各
14 鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移
15 動」之技術特徵。綜上，系爭專利請求項1相對於證據2、
16 6及7及甲證3具有進步性無疑。

17 (四) 證據2、6、7、8及甲證3之組合，不足以證明系爭專利請
18 求項2至10不具進步性：

19 1. 由於原告所舉之證據或證據組合揭示內容，均與系爭專利
20 請求項1有所歧異，且該證據或證據組合亦未對於該等技
21 術差異有所教示或建議，因此所屬技術領域中具有通常知
22 識者，無法徒以上開證據組合即輕易完成系爭專利請求項
23 1之所有技術特徵。

24 2. 又證據8僅揭示在連續式真空鍍膜中設置潛入式內部迴流
25 裝置，完全未論及系爭專利請求項1之連續型同步鍍膜設
26 備技術特徵。

27 3. 系爭專利請求項1之獨立項既具有進步性，則系爭專利請
28 求項2至請求項10等附屬項因包含請求項1之所有技術特
29 徵，自亦具有進步性。

30 (五) 另本院111年度行專訴字第49號曾就與系爭專利相對應之
31 發明第I513840號「多層膜的量產方法」專利有無進步性

01 為判決，判決結果認同原告所舉複數個證據之間並無組合
02 動機，且各證據亦與該發明專利有所差異，應可作為系爭
03 專利具進步性之參考。

04 (六) 聲明：

05 1.原告之訴駁回。

06 2.訴訟費用由原告負擔。

07 六、本件爭點（卷一第318、481頁）：

08 (一) 證據6，或甲證3，或證據2、6、7及甲證3之組合，是否足
09 以證明系爭專利請求項1不具進步性？

10 (二) 證據2、6、7、8及甲證3之組合，是否足以證明系爭專利
11 請求項2至10均不具進步性？

12 七、本院判斷：

13 (一) 應適用之法令：

14 系爭專利之申請日為104年1月21日，於同年2月14日經形
15 式審查准予專利（乙證2卷第19頁），原告於109年8月12
16 日主張系爭專利違反專利法第120條準用第22條第1項第1
17 款、第2項規定提起舉發，是以系爭專利有無撤銷原因，
18 應依核准時有效之103年1月22日修正公布、同年3月24日
19 施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。而依核准時專
20 利法第120條準用第22條第2項規定，新型為其所屬技術領
21 域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成
22 時，不得取得新型專利。

23 (二) 系爭專利之申請專利範圍：

24 系爭專利申請專利範圍共10項，其中請求項1為獨立項，
25 其餘均為附屬項。因系爭專利於112年1月18日更正請求項
26 1至10業經被告准予更正（卷一第423至424頁），並已於
27 同年3月1日公告（卷二第23頁），且兩造及參加人均同意
28 本件審理標的係為更正公告後之請求項（卷二第30頁），
29 故以下逕以更正後之請求項為準（主要圖式如附圖所
30 示）：

- 01 1.一種連續型同步鍍膜設備，包含：一個真空腔體，包括(n
02 +1)個緩衝區間，及n個鍍膜區間，該等緩衝區間與該等鍍
03 膜區間是沿一排列方向依序輪流設置， $n \geq 2$ 且是正整數；
04 n個陰極濺鍍靶組合，分別對應設置在該n個鍍膜區間，每
05 一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材；多數個載具，分別
06 載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該
07 多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行
08 一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝
09 區間三者間來回地移動；及一傳輸機構，設置於該真空腔
10 體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以
11 傳輸該等載具進行各鍍膜程序。
- 12 2.如請求項1所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該傳輸機
13 構包括(2n+1)個輸送組件，及(2n+1)個用以分別驅動該等
14 輸送組件的馬達，該傳輸機構之(2n+1)個輸送組件分別對
15 應設置在該等緩衝區間與該等鍍膜區間。
- 16 3.如請求項2所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該傳輸機
17 構之每一輸送組件具有多數滾輪，各輸送組件的該等滾輪
18 是用以承托傳輸該等載具進行各鍍膜程序。
- 19 4.如請求項2所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該傳輸機
20 構還包括(2n+1)個感應單元，該(2n+1)個感應單元分別對
21 應設置在該等緩衝區間與該等鍍膜區間，並用以偵測該等
22 載具的位置。
- 23 5.如請求項4所述的連續型同步鍍膜設備，其中，每一感應
24 單元具有一前感應器，及一後感應器。
- 25 6.如請求項1所述的連續型同步鍍膜設備，還包含一設置於
26 該真空腔體對應於第一個緩衝區間之一端的入口閥門、一
27 設置於該真空腔體對應於第(n+1)個緩衝區間之另一端的
28 出口閥門，及一銜接該出口閥門與該入口閥門的自動回流
29 單元。
- 30 7.如請求項6所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該自動回
31 流單元包括一與該出口閥門連接的載出腔、一與該入口閥

01 門連接的載入腔，及一連接該載出腔與該載入腔的回送機
02 構。

03 8.如請求項7所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該回送機
04 構具有一與該載出腔連接且能操控地使該等載具自該載出
05 腔向下移動的沉降段、一與該載入腔連接且能操控地使該
06 等載具向上移動至該載入腔的攀升段，及一位於該沉降段
07 與該攀升段之間的中繼段。

08 9.如請求項8所述的連續型同步鍍膜設備，其中，該沉降
09 段、該攀升段、該載出腔，及該載入腔各具有一輸送組
10 件，及一用以驅動其輸送組件的馬達，且該中繼段具有至
11 少一輸送組件及至少一用以驅動其輸送組件的馬達。

12 10.如請求項7所述的連續型同步鍍膜設備，還包含至少一連
13 接於該真空腔體的抽真空單元，該自動回流單元的載出腔
14 與載入腔分別具有一抽氣幫浦。

15 (三)原告所提舉發證據詳如附表及附圖所示(含新證據-甲證
16 3)，其公告日均早於系爭專利之申請日(104年1月21
17 日)，可作為系爭專利申請前之先前技術。

18 (四)證據6足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

19 1.依證據6說明書段落[0033]至[0035]與圖4至5揭示被動元
20 件之雙面覆膜設備之第二較佳實施例，其運作步驟可由第
21 一較佳實施例之運作步驟輕易地推測得知，該設備包括依
22 序設置之載入腔體8、第一低壓腔體3、製程腔體4、第二
23 低壓腔體5、載出腔體6及位於前述腔體內部之輸送系統
24 7，其中製程腔體4具有彼此連通且依序設置之第一緩衝空
25 間41、第一沉積空間42、第三緩衝空間45、第二沉積空間
26 43以及第二緩衝空間44，前述第一沉積空間42具有至少一
27 第五靶材423，第二沉積空間43具有至少一第六靶材433，
28 圖5顯示該設備可使多個待鍍物於不同沉積空間進行沉積
29 製程，[0021]至[0025]揭示輸送系統輸送待鍍物至各緩衝
30 空間進行緩衝動作、以及輸送待鍍物至各沉積空間進行沉
31 積製程，前述沉積製程例如為蒸鍍製程、離子鍍製程等，

01 [0037]揭示製程腔體4具有的第二內部壓力係小於第一低
02 壓腔體3具有的第一內部壓力或第二低壓腔體5具有的第三
03 內部壓力，[0038]揭示可使用沉積冶具來裝載待鍍物，[0
04 043]揭示待鍍物可於第一緩衝空間、第二緩衝空間或第三
05 緩衝空間內被進行緩衝動作，例如已被覆膜之待鍍物於原
06 處等待或者調整輸送系統之傳輸速度。

07 2. 依上可知，證據6揭示連續型同步鍍膜設備，包含一個腔
08 體（製程腔體4），包括(2+1)個緩衝區間（第一緩衝空間
09 41、第三緩衝空間45及第二緩衝空間44）及2個鍍膜區間
10 （第一沉積空間42及第二沉積空間43），該等緩衝區間與
11 該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置，2個陰極濺
12 鍍靶組合且每一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材（第五
13 靶材423及第六靶材433），多數個載具（裝載待鍍物之沉
14 積冶具），分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多
15 數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各
16 鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜
17 區間前後的緩衝區間之間移動；以及一傳輸機構（輸送系
18 統7），設置於該腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區
19 間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜程序。雖證
20 據6與系爭專利請求項1間有以下差異：(1)證據6未具體記
21 載製程腔體4為真空腔體（下稱差異一）；(2)證據6未具
22 體記載裝載待鍍物之沉積冶具於進行沉積製程時能於沉積
23 空間及其前後的緩衝空間三者間來回地移動（下稱差異
24 二）。

25 3. 關於差異一，依證據6說明書[0037]段落揭示製程腔體4具
26 有的第二內部壓力係小於第一低壓腔體3具有的第一內部
27 壓力或第二低壓腔體5具有的第三內部壓力，已教示製程
28 腔體4應具備更小的內部壓力；[0013]段落亦記載製程腔
29 體4內之第一沉積空間42及第二沉積空間43例如為蒸鍍腔
30 體、離子鍍腔體等（乙證1卷第25頁）。由於參酌系爭專
31 利說明書之「先前技術」可知真空濺鍍設備已廣泛應用於

01 大量鍍膜製程中（同上卷第54頁），及依原告所提之PVD
02 濺鍍原理（卷二第43頁），可知蒸鍍、離子鍍等鍍膜製程
03 一般係於真空環境下進行，因此所屬技術領域中具有通常
04 知識者利用申請時之通常知識，應可使製程腔體為真空，
05 以利鍍膜製程的進行。

06 4.關於差異二，依證據6說明書[0043]段揭示待鍍物可於緩
07 衝空間進行原處等待或者調整輸送系統之傳輸速度等緩衝
08 動作（乙證1卷第22頁），即已教示雙面覆膜設備並非以
09 單向勻速輸送待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍
10 膜均勻度等需求，使待鍍物反覆通過鍍膜區間，乃為鍍膜
11 技術領域中易於思及的技術手段。又依參加人另案申請之
12 甲證6發明專利（專利證號I513840）說明書之【先前技
13 術】記載：「〔0002〕一般用以在待鍍物表面鍍覆多層膜
14 的量產設備，多半是以一鍍膜生產線來完成。該鍍膜生產
15 線是沿一排列方向依序配置有在同一真空腔體內的一前緩
16 衝區間、多數個各含有不同靶材的鍍膜區間，及一個後緩
17 衝區間…〔0003〕在量產過程中，為均勻地鍍製出該等多
18 層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別
19 於各鍍膜區間的靶材下方位移多次」（卷一第445至446
20 頁），可見參加人自承在甲證6發明專利申請（103年12月
21 25日）前，為使待鍍物均勻地鍍製出該等多層膜，於各鍍
22 膜區間位移多次以反覆通過進行鍍膜，確為系爭專利申請
23 前一般鍍膜量產設備領域中之通常知識。

24 5.由於證據6已揭示雙面覆膜設備包括依序設置的緩衝空間
25 一沉積空間一緩衝空間（參其主要圖式），前述緩衝空間
26 係用以使待鍍物於此處進行緩衝動作，待鍍物可由沉積冶
27 具所裝載。又參酌為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，而
28 使待鍍物在前後緩衝區位移多次以反覆通過鍍膜區間，乃
29 為系爭專利申請前之通常知識，故所屬技術領域中具有通
30 常知識者，應可配合證據6之雙面覆膜設備而採用能於沉
31 積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶具

01 (使待鍍物停下並改變傳輸方向亦屬一種緩衝動作，可於
02 緩衝空間為之)，以調整待鍍物在製程腔體內的動作，例
03 如使待鍍物來回地反覆通過沉積空間及其前後的緩衝空
04 間。是以，系爭專利請求項1僅為證據6技術內容之簡單變
05 更，且相較於證據6亦未產生無法預期之功效，則系爭專
06 利請求項1應為所屬技術領域中具有通常知識者依證據6之
07 內容所能輕易完成，故證據6已足以證明系爭專利請求項1
08 不具進步性。

09 6. 被告及參加人雖抗辯證據6未揭示「多數個載具」或「多
10 數個待鍍物」，而係直接將待鍍物A傳輸進入製程腔體
11 內，與系爭專利請求項1界定之連續型同步鍍膜設備中具
12 有「多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地
13 於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動」之技術特徵不
14 同，且證據6係適用於「雙面覆膜」設備，該領域中通常
15 知識者不會有動機在雙面覆膜設備中設置載具載放待鍍
16 物，否則待鍍物被載具乘載的該面即無法進行鍍膜程序，
17 而不可能完成證據6的雙面覆膜功效等等。惟查：(1)依證
18 據6說明書[0038]段落內容已揭示可使用「沉積冶具」來
19 裝載待鍍物A（乙證1卷第23頁背面），且參證據6之主要
20 圖式（第5圖）可知待鍍物A有多個，則用以裝載待鍍物之
21 「沉積冶具」即相當於系爭專利請求項1所稱「載具」，
22 且證據6亦已揭示有「多數個待鍍物」存在，而上開段落
23 既有記載可利用沉積冶具進行待鍍物之翻面動作、沉積冶
24 具視需求可有多種不同之設計樣態等，是以沉積冶具所裝
25 載之待鍍物即可能透過翻面動作或不同設計以完成雙面覆
26 膜。(2)再者，依證據6說明書[0008]段落記載待鍍物之第
27 一表面（於第一沉積空間進行沉積製程的表面）與第二表
28 面（於第二沉積空間進行沉積製程的表面）選擇性地為相
29 同或相異（同上卷第26頁），換言之，證據6已教示第一
30 沉積空間及第二沉積空間均於待鍍物之相同表面進行沉積
31 製程之單面鍍膜型態，即已揭露系爭專利請求項1之連續

01 型同步鍍膜型態。因此，被告及參加人前揭所辯顯與證據
02 6揭示內容不符，尚無可採。

03 7.被告雖辯稱證據6未揭示或暗示系爭專利請求項1之「（每
04 一載具能於）各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三
05 者間來回地移動」，且亦無法輕易由證據6推及，參加人
06 復稱依證據6教示之技術內容係待鍍物要依序通過各腔
07 體，不可能從中獲得「每一載具…能於各鍍膜區間與各鍍
08 膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」之技術特徵云
09 云。惟查，證據6已教示雙面覆膜設備不以單向勻速輸送
10 待鍍物為必要，且為增加鍍膜厚度或提升鍍膜均勻度，使
11 待鍍物反覆通過鍍膜區間，屬系爭專利申請前之通常知
12 識，業如前述，則所屬技術領域中具有通常知識者，為提
13 升鍍膜均勻度或使鍍膜具有所需厚度等需求，即可採用能
14 於沉積空間及其前後的緩衝空間三者間來回移動的沉積冶
15 具，以使沉積冶具所承載之待鍍物可配合前述需求而在製
16 程腔體內作動，例如反覆通過沉積空間進行鍍膜等。是
17 以，系爭專利請求項1之「每一載具…能於各鍍膜區間與
18 各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間來回地移動」，應為所
19 屬技術領域中具有通常知識者所能簡單變更而完成之技術
20 特徵，故被告及參加人所辯尚非可採。

21 8.參加人另抗辯其發明第I513840號專利與系爭專利有對應
22 關聯性，本院111年行專訴字第49號另案判決認定證據6未
23 揭露其作動方式，且鍍膜設備不同於該發明專利，而可佐
24 證系爭專利具有進步性云云（卷一第571至572頁）。然
25 查：參加人之第I513840號發明專利請求項1所請為「多層
26 膜的量產方法」，包含「同時令第二個載具與第一個載具
27 分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍
28 膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第
29 一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時
30 分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間
31 兩者間位移至少一次」（同上卷第460至461頁）；系爭專

01 利請求項1所請為設備，包含「多數個載具，分別載放一
02 個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩
03 衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜
04 程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三
05 者間來回地移動」。換言之，就載具（包括其上所放置之
06 待鍍物）作動方式而言，參加人之第I513840號發明專利
07 請求項1係界定「兩個載具的同步位移」步驟，系爭專利
08 請求項1則係界定「單一載具能來回地移動」構件，並未
09 敘及使多數個載具同步位移等相對移動過程，兩者明顯為
10 不同之技術特徵。故該判決理由既係針對第I513840號發
11 明專利請求項1界定之「兩個載具的同步位移」所為比對
12 論述，即與系爭專利請求項1界定之構件不同，自無從以
13 該判決理由作為認定系爭專利請求項1具有進步性之依
14 據，參加人所辯並無可採。

15 (五) 甲證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

- 16 1. 系爭專利請求項1與甲證3相較，依甲證3說明書段落[004
17 5]至[0048]、圖1A至1C揭示直列式連續沉積裝置200，包
18 括預處理部212、第一沉積腔213、第二沉積腔214、第三
19 沉積腔215、第四沉積腔216、第五沉積腔217、第六沉積
20 腔218及後處理部219，預處理部212包括一裝載區212a及
21 一預處理腔212b，裝載區212a係一腔體，複數基板10於大
22 氣壓力下載入並堆疊於此腔體中，而後以排空單元將壓力
23 降低至可開始進行沉積之程度，第一至第六沉積腔213~2
24 18各設有緩衝部213a~218a，相鄰之腔體係透過經由所述
25 緩衝部213a~218a相連，緩衝部可防止自鄰接蒸發腔進入
26 之沉積材料在沉積時進入薄膜，第一至第六沉積腔213~2
27 18各具有排空單元；[0049]揭示第一至第五沉積腔213~2
28 17各具有一線性沉積源，此外，第六沉積腔218可具有一
29 線性沉積源、一點源型沉積源或一噴濺沉積裝置，[0051]
30 具體說明在第一沉積腔213中，第一與第二沉積源12、13
31 沿基板傳遞方向交替排列，在第二沉積腔214中，複數第

01 三沉積源14沿基板傳遞方向排列，在第三沉積腔215中，
02 第四沉積源15a、15b、15c與第五沉積源16a、16b沿基板
03 傳遞方向交替排列，在第四沉積腔216中，複數第七沉積
04 源17沿基板傳遞方向排列，在第五沉積腔217中，複數第
05 八沉積源18沿基板傳遞方向排列；[0056]揭示傳遞單元將
06 基板10在其中以圖面自左至右之方向傳遞。

07 2.由上可知，甲證3揭示連續型同步鍍膜設備，包括6個緩衝
08 區間（緩衝部213a~218a）及6個鍍膜區間（第一至第六
09 沉積腔213~218），該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一
10 排列方向依序輪流設置，6個陰極濺鍍靶組合且每一陰極
11 濺鍍靶組合具有至少一種靶材（分別位於第一至第六沉積
12 腔的沉積源），多數待鍍物（複數基板10）分別能被控制
13 地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一
14 待鍍物於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區
15 間與各鍍膜區間前後的緩衝區間之間移動；及一傳輸機構
16 （傳遞單元），設置於該腔體，且於該等緩衝區間、該等
17 鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等待鍍物進行各鍍膜程
18 序。然系爭專利請求項1與甲證3間仍有以下差異：(1)甲
19 證3所揭示沉積腔與緩衝部數目並非n與n+1之關係，且非
20 設置於一真空腔體內（甲證3之沉積腔與緩衝部數目相
21 等，且每一沉積腔各自具有排空單元，於圖中亦可見沉積
22 腔與緩衝部並未相連通）；(2)甲證3未具體記載以載具載
23 放基板；(3)甲證3未具體記載載具/基板於進行沉積製程
24 時能於沉積腔及其前後的緩衝部三者間來回地移動。

25 3.關於上開差異(2)，利用載具承載基板以於鍍膜裝置中移
26 動，應屬鍍膜技術領域之通常知識；關於上開差異(3)，
27 承前所述，所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之
28 通常知識，為因應鍍膜厚度或均勻度等需求，應可採用能
29 於沉積腔及其前後的緩衝部三者間來回地移動的載具，以
30 調整基板在進行沉積時的作動（包括移動路徑等）。惟關
31 於上開差異(1)，依甲證3說明書段落[0054]已具體記載將

01 基板10自預處理腔212b傳遞入第一沉積腔213，亦即預處
02 理腔212b與第一沉積腔213應鄰接地設置，所屬技術領域
03 中具有通常知識者尚無動機在第一沉積腔213前方再另行
04 設置一緩衝部；再者，依甲證3說明書段落[0048]揭示緩
05 衝部之設置係為防止自鄰接蒸發腔進入之沉積材料在沉積
06 時進入薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者即無從將甲
07 證3的各沉積腔與各緩衝部變更為相連通地設置於一真空
08 腔體內，否則可能影響緩衝部對鄰接沉積腔之沉積材料的
09 隔離作用。因此，甲證3並未揭示或教示系爭專利請求項1
10 所界定上開差異(1)之技術特徵，且所屬技術領域中具有
11 通常知識者亦無動機將甲證3所揭示直列式連續沉積裝置
12 進行簡單變更而完成系爭專利請求項1，尚難依甲證3之揭
13 示或教示而能輕易完成系爭專利請求項1之新型。是以，
14 甲證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

15 4.原告雖主張依甲證3圖1A揭示結構中的「緩衝部213a-第二
16 沉積腔214-緩衝部214a-第三沉積腔215-緩衝部215a」部
17 分，可對應於系爭專利請求項1界定之 $n+1$ 個緩衝區間及 n
18 個鍍膜區間云云（卷一第339至340頁）。惟查，甲證3之
19 鍍膜生產線實為具有6個緩衝區間（緩衝部213a至218a）
20 及6個鍍膜區間（沉積腔213至218），原告雖於甲證3圖1A
21 框示鍍膜生產線之特定部分，但不代表具有緩衝部213a、
22 沉積腔214、緩衝部214a、沉積腔215及緩衝部215a之鍍膜
23 生產線即可執行甲證3之鍍膜技術，故原告擷取甲證3圖1A
24 之特定部分而非完整檢視甲證3之技術內容，應非可採。
25 況且，系爭專利請求項1相較於甲證3之差異並非僅在沉積
26 腔與緩衝部之 n 與 $n+1$ 數目關係，如前所述，甲證3之沉積
27 腔與緩衝部並非設置於一真空腔體內，所屬技術領域中具
28 有通常知識者仍無從將甲證3的各沉積腔與各緩衝部變更
29 為相連通地設置於一真空腔體內，以避免影響緩衝部對鄰
30 接沉積腔之沉積材料的隔離作用，故原告主張甲證3足以
31 否定系爭專利請求項1之進步性，即不可採。

01 (六) 證據2、6、7及甲證3之組合，足以證明系爭專利請求項1
02 不具進步性：

03 由於證據6足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前
04 述，則證據6與證據2、7及甲證3之組合，當亦足以證明系
05 爭專利請求項1不具進步性。

06 (七) 證據2、6、7、8及甲證3之組合，足以證明系爭專利請求
07 項2至10不具進步性：

08 1.系爭專利請求項2、3部分：

09 (1)系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，請求項3為請求項2
10 之附屬項，均包含請求項1之技術特徵。又請求項2進一步
11 界定「其中，該傳輸機構包括 $(2n+1)$ 個輸送組件，及 $(2n+$
12 $1)$ 個用以分別驅動該等輸送組件的馬達，該傳輸機構之 $(2$
13 $n+1)$ 個輸送組件分別對應設置在該等緩衝區間與該等鍍膜
14 區間」，請求項3則進一步界定「其中，該傳輸機構之每
15 一輸送組件具有多數滾輪，各輸送組件的該等滾輪是用以
16 承托傳輸該等載具進行各鍍膜程序」。

17 (2)證據8說明書第11頁揭示連續式真空鍍膜生產裝置之進料
18 腔體區10、鍍膜腔體區11、出料腔體區12，各腔體區內分
19 別設有動力輸出設備13，以分別驅動一組輸送滾輪14轉
20 動。可知證據8已教示鍍膜生產裝置中配置由馬達驅動的
21 複數滾輪，以輸送承載盤通過各腔體區。因此，所屬技術
22 領域中具有通常知識者於組合證據6及證據8後，應可在證
23 據6覆膜設備中分別對應第一緩衝空間41、第一沉積空間4
24 2、第三緩衝空間45、第二沉積空間43及第二緩衝空間4
25 4，而設置5套輸送組件及馬達，該輸送組件由複數滾輪組
26 成，以承托傳輸裝載有待鍍物之沉積冶具，並未產生無法
27 預期之功效。故系爭專利請求項2、3乃為所屬技術領域中
28 具有通常知識者依證據6及證據8之組合所能輕易完成，故
29 證據6、8之組合足以證明系爭專利請求項2、3不具進步
30 性。

01 (3)又證據6係關於運用蒸鍍製程、離子鍍製程等的覆膜設
02 備，說明書段落[0033]至[0035]等具體揭露該設備包括依
03 序設置之載入腔體8、第一低壓腔體3、製程腔體4、第二
04 低壓腔體5、載出腔體6及位於前述腔體內部之輸送系統
05 7；證據8係關於自動化潛入式內部迴流裝置，說明書第11
06 頁及第1圖、第2圖等具體揭露其利用原有之連續式真空鍍
07 膜生產裝置而形成潛入式內部迴流裝置，依序設有連續真
08 空鍍膜所需的進料腔體區10、鍍膜腔體區11、出料腔體區
09 12等，且於分別承置有前述腔體區的進料基台15、鍍膜基
10 台16、出料基台17之間設有一回傳機構模組40。故證據
11 6、8均屬「鍍膜技術」領域，均涉及鍍膜設備之機構與操
12 作效率問題，且證據8所載「利用原有之連續式真空鍍膜
13 生產裝置」，亦已隱含結合證據6覆膜設備之教示或建
14 議，熟習該項技術領域者為提升證據6所揭示覆膜設備之
15 效率，當會有動機組合證據6及證據8之技術內容，故兩者
16 具有結合之動機。

17 2.系爭專利請求項4、5部分：

18 (1)系爭專利請求項4為請求項2之附屬項，請求項5為請求項4
19 之附屬項，均包含所依附請求項之技術特徵。又請求項4
20 進一步界定「其中，該傳輸機構還包括 $(2n+1)$ 個感應單
21 元，該 $(2n+1)$ 個感應單元分別對應設置在該等緩衝區間與
22 該等鍍膜區間，並用以偵測該等載具的位置」、請求項5
23 進一步界定「其中，每一感應單元具有一前感應器，及一
24 後感應器」。

25 (2)證據8說明書第13頁揭示承載盤50的前端先被感測開關34
26 感測到，感測開關34感測訊號後會驅動動力源而帶動滾輪
27 旋轉，使承載盤50繼續前進至定位感測開關35為止，定位
28 感測開關35的感測訊號則使動力源停止運轉，可知證據8
29 已教示利用成組的兩個感測開關感應承載盤之位置，以於
30 製程中控制承載盤的輸送。所屬技術領域中具有通常知識
31 者組合證據6及8而於證據6覆膜設備中設置輸送組件及馬

01 達後，即可進一步分別對應第一緩衝空間41、第一沉積空
02 間42、第三緩衝空間45、第二沉積空間43及第二緩衝空間
03 44而設置5組感應單元，該等感應單元各自由兩個感測開
04 關組成，以偵測沉積冶具之位置而控制其輸送，且未產生
05 無法預期之功效，故系爭專利請求項4、5為所屬技術領域
06 中具有通常知識者依證據6及8之組合所能輕易完成者，且
07 證據6、8具有結合之動機，已如前述，故其結合自足以證
08 明系爭專利請求項4、5不具進步性。

09 3.系爭專利請求項6部分：

- 10 (1)系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，除包含請求項1之
11 技術特徵外，並進一步界定「還包含一設置於該真空腔體
12 對應於第一個緩衝區間之一端的入口閥門、一設置於該真
13 空腔體對應於第(n+1)個緩衝區間之另一端的出口閥門，
14 及一銜接該出口閥門與該入口閥門的自動回流單元。」。
- 15 (2)證據8說明書第11頁及第1圖、第2圖等揭示利用原有之連
16 續式真空鍍膜生產裝置而形成潛入式內部迴流裝置，依序
17 設有連續真空鍍膜所需的進料腔體區10、鍍膜腔體區11、
18 出料腔體區12等，且於分別承置有前述腔體區的進料基台
19 15、鍍膜基台16、出料基台17之間設有一回傳機構模組4
20 0，進料基台15側設有前置基台18，出料基台17側設有後
21 置基台19。可知證據8已教示鍍膜腔體區11之出口閥門與
22 入口閥門由一組自動回流單元銜接（依序包括出料腔體區
23 12-後置基台19-回傳機構模組40-前置基台18-進料腔體區
24 10），以循環輸送承載盤。因此，所屬技術領域中具有通
25 常知識者於組合證據6及8，即可進一步於證據6覆膜設備
26 設置銜接製程腔體的出口閥門與入口閥門的自動回流單
27 元，將由製程腔體載出的沉積冶具回送至製程腔體的入口
28 處，以重新鍍製另一待鍍物，且未產生無法預期之功效。
29 故系爭專利請求項6為所屬技術領域中具有通常知識者依
30 證據6及8之組合所能輕易完成者，且證據6、8具有結合動

01 機，已如前述，其結合足以證明系爭專利請求項6不具進
02 步性。

03 4.系爭專利請求項7部分：

04 (1)系爭專利請求項7為請求項6之附屬項，除包含請求項6之
05 技術特徵外，並進一步界定「其中，該自動回流單元包括
06 一與該出口閥門連接的載出腔、一與該入口閥門連接的載
07 入腔，及一連接該載出腔與該載入腔的回送機構。」。

08 (2)證據8說明書第11頁及第1圖、第2圖等揭示潛入式內部迴
09 流裝置包括出料腔體區12、後置基台19、回傳機構模組4
10 0、前置基台18、進料腔體區10等配置。可知證據8已教示
11 鍍膜腔體區11之出口閥門與入口閥門由一組自動回流單元
12 銜接（依序包括出料腔體區12-後置基台19-回傳機構模組
13 40-前置基台18-進料腔體區10），以循環輸送承載盤。所
14 屬技術領域中具有通常知識者組合證據6及8而於證據6覆
15 膜設備設置自動回流單元時，即可使該自動回流單元包括
16 既有之第二低壓腔體5與載出腔體6（與製程腔體4的出口
17 閘門連接）、載入腔體8與第一低壓腔體3（與製程腔體4
18 的入口閘門連接）、以及連接載出腔體6與載入腔體8的回
19 送機構，且未產生無法預期之功效。故系爭專利請求項7
20 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據6及證據8之組合
21 所能輕易完成者，且證據6、8具有結合動機，其結合足以
22 證明系爭專利請求項7不具進步性。

23 5.系爭專利請求項8部分：

24 (1)系爭專利請求項8為請求項7之附屬項，除包含請求項7之
25 技術特徵外，並進一步界定「其中，該回送機構具有一與
26 該載出腔連接且能操控地使該等載具自該載出腔向下移動
27 的沉降段、一與該載入腔連接且能操控地使該等載具向上
28 移動至該載入腔的攀升段，及一位於該沉降段與該攀升段
29 之間的中繼段。」。

30 (2)證據8說明書第11至12頁及第1圖、第2圖等揭示潛入式內
31 部迴流裝置包括出料腔體區12、後置基台19、回傳機構模

01 組40、前置基台18、進料腔體區10等配置，於前置基台18
02 及後置基台19內分別設有前升降裝置及後升降裝置，由第
03 1圖則可見於後置基台19內的後升降裝置係用以沉降自出
04 料腔體區12載出的承載盤50，前置基台18內的前升降裝置
05 則係用以升起承載盤以載入進料腔體區10。可知證據8已
06 教示鍍膜腔體區11之出口閥門與入口閥門由一組自動回流
07 單元銜接（依序包括出料腔體區12-後置基台19-回傳機構
08 模組40-前置基台18-進料腔體區10），以循環輸送承載
09 盤，且後置基台19內設有後升降裝置以使承載盤50向下移
10 動，前置基台18內設有前升降裝置以使承載盤向上移動。
11 所屬技術領域中具有通常知識者組合證據6及8而於證據6
12 覆膜設備設置自動回流單元時，即可使連接載出腔體6與
13 載入腔體8的回送機構包括使沉積冶具自載出腔體6向下移
14 動的沉降段、使沉積冶具向上移動至載入腔體8的攀升
15 段、以及位於沉降段與攀升段之間的中繼段，且未產生無
16 法預期之功效。故系爭專利請求項8為所屬技術領域中具
17 有通常知識者依證據6及8之組合所能輕易完成者，且證據
18 6、8具有結合動機，其結合足以證明系爭專利請求項8不
19 具進步性。

20 6. 系爭專利請求項9部分：

- 21 (1) 系爭專利請求項9為請求項8之附屬項，除包含請求項8之
22 技術特徵外，並進一步界定「其中，該沉降段、該攀升
23 段、該載出腔，及該載入腔各具有一輸送組件，及一用以
24 驅動其輸送組件的馬達，且該中繼段具有至少一輸送組件
25 及至少一用以驅動其輸送組件的馬達。」。
- 26 (2) 證據8說明書第11至12頁及第1圖、第2圖等揭示潛入式內
27 部迴流裝置包括出料腔體區12、後置基台19、回傳機構模
28 組40、前置基台18、進料腔體區10等配置，其中進料腔體
29 區10、出料腔體區12等腔體區內分別設有動力輸出設備13
30 以分別驅動一組輸送滾輪14轉動，設置於前置基台18及後
31 置基台19內的前升降裝置及後升降裝置則分別具有由動力

源21、31帶動的滾輪22、32，另回傳機構模組40亦設有由動力源42帶動的複數滾輪41。可知證據8已教示鍍膜生產裝置可對應配置多組由馬達驅動的複數滾輪，以進行承載盤的輸送。所屬技術領域中具有通常知識者組合證據6及8而於證據6覆膜設備設置自動回流單元時，即可在該自動回流單元的沉降段、攀升段、載出腔體6、載入腔體8與中繼段分別設置由複數滾輪構成之輸送組件與用以驅動該等滾輪的馬達，以傳輸沉積冶具，且未產生無法預期之功效。故系爭專利請求項9為所屬技術領域中具有通常知識者依證據6及證據8之組合所能輕易完成者，且證據6、8具有結合動機，其組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

7.系爭專利請求項10部分：

- (1)系爭專利請求項10為請求項7之附屬項，除包含請求項7之技術特徵外，並進一步界定「還包含至少一連接於該真空腔體的抽真空單元，該自動回流單元的載出腔與載入腔分別具有一抽氣幫浦。」。
- (2)依證據6說明書段落[0013]揭示第一低壓腔體3及第二低壓腔體5之壓力介於 10^{-2} 托至 10^{-6} 托，[0016]揭示進行降低腔體內常壓動作於載入腔體，[0020]揭示進行將腔體內壓力抽氣之低壓動作於第一低壓腔體，[0037]揭示製程腔體4具有的第二內部壓力係小於第一低壓腔體3具有的第一內部壓力或第二低壓腔體5具有的第三內部壓力；另證據8說明書第11頁及第1圖、第2圖等揭示利用連續式真空鍍膜生產裝置而形成潛入式內部迴流裝置。可知證據6已教示製程腔體4應具備更小的內部壓力且可藉由抽氣降低各腔體之壓力，證據8已教示真空鍍膜製程，所屬技術領域中具有通常知識者組合證據6及8而於證據6覆膜設備設置自動回流單元時，即可使該自動回流單元所包括之各腔體具有抽氣幫浦以降低腔體壓力，亦可於製程腔體4設置抽真空單元以控制真空鍍膜製程之進行，且未產生無法預期之功效。

01 效，故系爭專利請求項10為所屬技術領域中具有通常知識
02 者依證據6及證據8之組合所能輕易完成者，且證據6、8具
03 有結合動機，其組合足以證明系爭專利請求項10不具進步
04 性。

05 8. 基上，在證據6、8之組合即足以證明系爭專利請求項2至1
06 0不具進步性之情況下，則證據6、8進一步與證據2、7及
07 甲證3之組合，當然亦足以證明系爭專利請求項2至10不具
08 進步性。

09 八、綜上所述，本件依原告所舉證據6，或證據2、6、7及甲證3
10 之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性（雖甲
11 證3不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性）；證據
12 2、6、7、8及甲證3之組合足以證明系爭專利更正後請求項2
13 至10不具進步性。從而，原處分關於系爭專利更正後請求項
14 1至10舉發不成立之審定，即有違誤，訴願決定予以維持，
15 亦有未洽，原告請求撤銷訴願決定及原處分關於更正後請求
16 項1至10部分，並命被告就系爭專利更正後請求項1至10應作
17 成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。

18 九、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
19 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的
20 必要。

21 十、結論：原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1
22 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

23 中 華 民 國 112 年 6 月 8 日

24 智慧財產第一庭

25 審判長法 官 蔡惠如

26 法 官 陳端宜

27 法 官 吳俊龍

28 以上正本證明與原本無異。

29 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
30 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
31 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決

01 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

02 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第

03 241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師

04 為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

05 06 得不委任律師為訴訟 07 代理人之情形	08 所需要件
09 10 (一)符合右列情形之一 11 者，得不委任律師 12 為訴訟代理人	13 14 1. 上訴人或其法定代理人具備律師資 15 格或為教育部審定合格之大學或獨 16 立學院公法學教授、副教授者。 17 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代 18 理人具備會計師資格者。 19 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代 20 理人具備專利師資格或依法得為專 21 利代理人者。
22 23 (二)非律師具有右列情 24 形之一，經最高行 25 政法院認為適當者 26 ，亦得為上訴審訴 27 訟代理人	28 29 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、 30 二親等內之姻親具備律師資格者。 31 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者 。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或 依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關 、公法上之非法人團體時，其所屬 專任人員辦理法制、法務、訴願業 務或與訴訟事件相關業務者。
32 33 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴 34 人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明 35 文書影本及委任書。	

01

02 中 華 民 國 112 年 6 月 17 日

03

書記官 蔣淑君

04 附表：

05

證 據	內 容	卷宗所在頁
證據2	西元2005年1月18日公告之美國第6843892B1號「APPARATUS AND METHOD FOR SELECTIVELY AND CONTROLLABLY ELECTRICALLY BIASING A PLURALITY OF SUBSTRATES ON A PALLET」專利案	原處分卷 第43頁
證據3	德威電子(昆山)有限公司(係原告從屬公司)與晟碟半導體(上海)有限公司的電子郵件往來紀錄	原處分卷 第37頁
證據4	原告對晟碟半導體(上海)有限公司的In-Line濺鍍系統設備報價單(證據3之附件)	原處分卷 第35頁
證據5	原告In-Line濺鍍機一型號:UHS-51524D濺鍍系統設備技術規格書(證據3之附件)	原處分卷 第34頁
證據6	西元2012年11月11日公告之我國第M441293號「適用於被動元件之雙面覆膜設備」專利案	原處分卷 第29頁
證據7	西元1994年8月23日公告之美國第5340454號「METHOD AND APPARATUS FOR THE COATING OF SUBSTRATES」專利案	原處分卷 第16頁
證據8	西元2005年3月1日公告之我國第M258101號「自動化潛入式內部迴流裝	原處分卷 第13頁

	置」新型專利案	
甲證3 (新證據)	西元2012年9月20日公開之美國第2012/0237669A1號「Successive Deposition Apparatus and Successive Deposition Method」專利申請案	原處分卷 第127頁
註：系爭專利申請日為西元2015年1月21日		